(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公問番号

特開平11-339340

(43)公開日 平成11年(1999)12月10日

(51) Int.CL*

識別記号

G11B 11/10

586

FI

G11B 11/10

586B

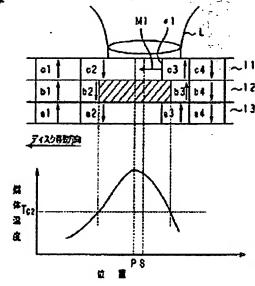
審査請求 未請求 請求項の数6 QL (全 11 頁)

(21)出願為好	特願平10-140254	(71)出頭人	000002185 キャラ
(22) IIIM B	平成10年(1998) 5 月21日	(72)発明者	東京都島川区北島川 6 丁目 7 番35号 福本 教
			東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内
		(72)発明者	甲斐 慎一 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内
		(72) 発明者	横原 立也 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内
		(74)代理人	弁理士 小池 晃 (外2名)

(54) 【発明の名称】 記録装置、記録方法及び光磁気記録媒体 (57) 【要約】

【課題】 DWDD(Domain Wall Displacement Detect ion)方式におけるゴースト現象を解消して、光磁気記録 媒体の更なる高記録密度化を実現する。

【解決手段】 DWDD方式によって光磁気記録媒体から信号を再生するにあたって、光磁気記録媒体に対する記録にマークボジション記録方式を採用する。マークボジション記録方式では、記録マーク長を変調して信号を記録するマークエッジ記録方式などと異なり、記録マーク長は常に一定で良く、しかも、当該記録マーク長は非常に短くて良い。そして、DWDD方式におけるゴースト現象は、記録マークが十分に小さいときには生じない。したがって、記録にマークボジション記録方式を採用することにより、DWDD方式におけるゴースト現象を解消することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 少なくとも3層の磁性層からなる磁性多 層膜を記録層として備え、再生時に再生光スポットの走 行方向前方において再生光照射側の磁性層の磁壁がスポー ット中心方向に移動して記録磁区が拡大されるようにな された光磁気記録媒体に対して、デジタル信号を記録す る記録装置であって、

記録マークの間隔を変調させて信号を記録するマークボ ジション記録方式により、上記光版気記録媒体に対して デジタル信号を記録する記録手段を備えていることを特 徴とする記録装置。

【請求項 2】 上記記録マークのマーク長が2 p m以下 であ ることを特徴とする請求項 1記載の記録装置。

【請求項 3】 少なくとも3層の磁性層からなる磁性多 層限を記録層として備え、再生時に再生光スポットの走 行方向前方において再生光照射側の磁性層の磁壁がスポ ット中心方向に移動して記録磁区が拡大されるようにな された光磁気記録媒体に対してデジタル信号を記録する にあ たって、

記録マークの間隔を変調させて信号を記録するマークボ ジション記録方式により、上記光磁気記録媒体に対して デジタル信号を記録することを特徴とする記録方法。

【請求項 4】 上記記録マークのマーク長を2 μ m以下 とすることを特徴とする請求項 3記載の記録方法。

【請求項 5】 少なくとも3層の磁性層からなる磁性多 **層膜を記録層として備え、再生時に再生光スポットの走** 行方向前方において再生光照射側の磁性層の磁壁がスポ ット中心方向に移動して記録磁区が拡大されるようにな

された光磁気記録媒体であって、 記録マークの間隔を変調させて信号を記録するマークボ ジション記録方式によりデジタル信号が記録されること を特徴とする光磁気記録媒体。

【請求項 6】 上記記録マークのマーク長が2 p m以下 であることを特徴とする請求項 5記載の光磁気記録媒: 医线性强力 医皮肤

.

[発明の詳細な説明]

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、磁壁移動により記 緑磁区を拡大して信号の再生を行う光磁気記録媒体、並 びにそのような光磁気記録媒体に対してデジタル信号を 記録する記録装置及び記録方法に関するものであ り、特 にゴースト現象を解消するための技術に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、少なくともディスプレイスメント 層、スイッチ層及びメモリ層の3層の磁性層からなる磁 性多層膜を記録層として用い、信号の再生時に、
関温度 がスイッチ層のキュリー温度以上となった領域でのディ スプレイスメント層の磁量移動を利用することにより、 実効的に記録嵌区の大きさを拡大して再生信号を大きく する光磁気再生方式が提案されている。

[0003] DWDD (Domain Wall Displacement Det ection) と呼ばれるこの方式では、再生時に、再生光ス ポットの走行方向前方において再生光照射側の磁性層 (すなわちディスプレイスメント層)の磁量がスポット 中心方向に移動して記録磁区が拡大される。 したがっ て、DWDD方式を採用することにより、再生光の光学 的な限界分解能以下の周期の微小記録磁区からも非常に 大きな信号を再生することが可能となり、再生光の波長 や対物レンズの開口数等を変更することなく、更なる高 記録密度化を図ることが可能となる。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、 DWD D方式においては、未た解決すべき問題点が多く、 その -つにゴーストの問題がある。

【0005】DWDD方式により信号の再生を行うと、 ある記録故区に対応する信号が現れた後、当該記録故区 に対応する信号が一旦消え、その後、あ る時間を経過し た後に再び当該記録磁区に対応する信号が現れるという 挙動を示すことがあ る。これがゴーストと呼ばれる現象 であり、ある時間を経過した後に再び現れる信号はゴー スト信号と呼ばれる。そして、このようなゴースト信号 は、再生信号のノイズとなるため、DWDD方式を採用して高記録密度化を図る上での妨げとなっている。

【0006】本発明は、以上のような従来の実情に鑑み て提案されたものであ り、DWDD方式におけるゴース ト現象を解消することが可能な記録装置及び記録方法並。 びに光磁気記録媒体を提供することを目的としている。 [0007]

e de di

A 112

【課題を解決するための手段】本発明に係る記録装置: は、光磁気記録媒体に対してデジタル信号を記録する記 録装置である。ここで、記録対象となる光磁気記録媒体 は、少なくとも3層の磁性層からなる磁性多層膜を記録。 層として備え、再生時に再生光スポットの走行方向前方 において再生光照射側の磁性層の磁壁がスポット中心方 (1977) (1977) 向に移動して記録磁区が拡大されるようになされた光磁 気記録媒体である。そして、本発明に係る記録装置は、 記録マークの間隔を変調させて信号を記録するマークボ ジション記録方式により上記光磁気記録媒体に対してデ ジタル信号を記録する記録手段を備えていることを特徴 とする。なお、上記記録装置において、光磁気記録媒体 に記録する記録マークのマーク長は、2μm以下である ことが好ましい。

【0008】以上のような本発明に係る記録装置では、 デジタル信号の記録にマークポジション記録方式を採用 している。マークポジション記録方式では、記録マーク 長を変調して信号を記録するマークエッジ記録方式など と異なり、記録マーク長は常に一定で良く、しかも、当 該記録マーク長は非常に短くて良い。そして、DWDD 方式におけるゴースト現象は、記録マークが十分に小さ いときには生じない。したがって、デジタル信号の記録

にマークポジション記録方式を採用した本発明に係る記録装置では、DWDD方式におけるゴースト現象を解消することができる。

【0009】また、本発明に係る記録方法は、光磁気記録域体に対してデジタル信号を記録する記録方法に対する。ここで、記録対象となる光磁気記録媒体は、少なくとも3層の磁性層からなる磁性を層限方におけた向前方において発展を開発してで、本発明に係る記録方としてで記録破区が拡大されるようになされた光磁気記録媒体である。そして、本発明に係る記録方法は、記録マークの間隔を変調させて信号を記録するマークボジション記録方式により、上記光磁気記録媒体に対してデジタル信号を記録することを特徴とする。なおよマークのマーク長は、2μm以下であることが好ましい。

【0010】以上のような本発明に係る記録方法では、デジタル信号の記録にマークポジション記録方式を採用している。マークポジション記録方式では、記録マーク長を変調して信号を記録するマークエッジ記録方式などと異なり、記録マーク長は非常に定くて良い。そして、DWDD方式におけるゴースト現象は、記録マークが十分に小さいときには生じない。したがって、デジタル信号の記録方法では、DWDD方式におけるゴースト現象はには大きには大きない。したがって、デジタル信号の記録方法では、DWDD方式におけるゴースト現象を解消することができる。

【0011】また、本発明に係る光磁気記録媒体は、少なくとも3層の磁性層からなる磁性多層膜を記録層として備え、再生時に再生光スポットの走行方向前方において再生光照射側の磁性層の磁型がスポット中心方向に移動して記録磁区が拡大されるようになされた光磁気記録媒体は、記録マークの間隔を変調させて信号を記録するマークポジション記録方式によりデジタル信号が記録されることを特徴とする。なお、上記光磁気記録媒体に記録される記録マークのマーク長は、2μm以下であることが好ましい。

【0012】以上のような本発明に係る光磁気記録媒体では、デジタル信号の記録にマークボジション記録方式では、記録マーク長を変調して信号を記録するマークエッジ記録方式などと異なり、記録マーク長は常に一定で良く、しかも、当該記録マーク長は非常に強くて良い。そして、DWD方式におけるゴースト現象は、記録マークが十分の記録にマークがピラの記録にマークがジション記録方式を採用した本第明に係る光磁気記録媒体では、DWDD方式におけるゴースト現象を解消することができる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。

【0014】本発明が適用される光磁気記録媒体の基本的な構成を図1に示す。この光磁気記録媒体は、DWDD方式によって信号が再生される光磁気記録媒体であるが、その基本的な構成は、通常の光磁気記録媒体と同様である。すなわち、この光磁気記録媒体は、図1に示すように、透明基板1の上に誘電体膜2、記録程3、誘電体膜4、反射膜5、保護膜5が頂次積層形成されてなる

【0015】上記誘電体膜2,4は、例えば室化珪素からなる。ただし、誘電体膜2,4の材料は、これに限らず、酸化珪素や窒化アルミニウム等、他の誘電体材料を用いてもよい。また、上記反射膜5は、入射された光を反射するためのものであり、例えばアルミニウムからなる。また、上記保護膜6は、誘電体膜2、記録層3、誘電休膜4及び反射膜5を保護するためのものであり、例えば紫外線硬化樹脂からなる。これら各例えば、誘電体膜2の膜厚を70nm、反射膜5の膜厚を70nm、反射膜5の膜厚を30nmとする。

【0016】なお、ここでは、記録再生用の光が透明基準は1の側から照射されることを前提とするが、逆に、記録再生用の光が保護限6の側から照射されるような構成とすることも可能である。その場合には、反射限5の形成位置が誘電体限2と透明基板1の間になること、並びをは、後述する記録層3の層構成が逆になることが上記構成とは異なる。

【0017】そして、本発明が適用される光磁気記録は、そのようでは、10017】そして、本発明が適用される光磁気記録は、そのようでは、10017月であり、記録度3は、ディスプレイスメント度ができる。 10017月 1003 度から、で、アイスプレイスメント度112 まるに、再生光入射側から、ディー・では、10017月 1003 度の磁性度が検尿され、これらによりに記録度3が3 度構 には、10017月 1003 度が、本発明が適用すれる光で、アイスでは、記録度3が3 度構 には、10017月 1003 度が、10017月 1003 度が、100

【0018】上記記録習るを構成する基础は増11、12、13には、DWDD方式によって信号を再生できるようするために、以下のような特性が要求される。【0019】まず、ディスプレイスメント層11であるが、このディスプレイスメント層11は、再生時の温度においても十分な信号が再生される必要があり、したがって、キュリー温度が高く、カー回転角が大きいことが必要である。少なくとも、ディスプレイスメント層11のキュリー温度TCIは、スイッチ層12のキュリー温度TCIは、スイッチ層12のキュリー温度TCIは、スイッチ層12のキュリー温度TCIは、スイッチ層12のキュリー温度TCIは、スイッチ層12のキュリー温度TCIは、スイッチ層12のキュリー温度TCIは、スイッチ層12のキュリー温度TCIは、スイッチ層12のキュリー温度

【0020】また、ディスプレイスメント層!1は、再 生時にスイッチ層12との交換結合が切れた際に、 に改革が移動するようになされていなければならず、協 解放用やがしょうとなった。 筆抗協力が小さくなけらばならない。具体的には、ディ スプレイスメント層1 1 の磁盤抗磁力は、 1 kO e以下 であ ることが好ましい。

【0021】また、ディスプレイスメント層11は、そ、 和自身の浮遊磁界で磁盤の移動が助けられないように、 蛇和磁化の小さい材料からなることが望ましい。具体的/ には、ディスプレイスメント層の飽和磁化は、10 Den

u/cc 以下であ ることが好ましい。 【0022】また、ディスプレイスメント層 1 1 の膜厚 は、カー回転角が飽和するに足る膜厚以上であ れば十分 であり、具体的には、20mm~40mm程度が好まし

【0023】以上のようなディスプレイスメント層11 の材料としては、例えば、GdFeCoやGdFeCr 等が挙げられる。

【0024】つきに、スイッチ層12であ るが、このス イッチ屋12は、ディスプレイスメント屋11とメモリ 層13との交換結合を一定の温度で遮断する役割を担う。 へ ため、その設定温度にあ たる所定のキュリー温度TC2を 有することが必要である。

【0025】また、スイッチ層12の関厚は、ディスプ レイスメント層11とメモリ層13との交換結合を均一、 且つ確実に遮断できる程度は必要であり、具体的には、/ 5nm程度以上であ ることが好ましい。ただし、スイッ チ層12の映厚は、あ まり厚すぎてもメリットは無いの で、20mm程度以下とすることが好ましい。

【0026】以上のようなスイッチ層 12の材料として は、例えば、TibFeやTbFeCr等が挙げられる。 【0027】つきに、メモリ層13であるが、このメモリ層13は、記録機区を保持する層であり、再生時にも安定に微小記録機区形状を保持しなければならない。し たがって、メモリ層13は、そのキュリー温度TC3がス イッチ層12のキュリー温度TC2以上でなければなら ず、さらに、微小な記録磁区を安定に保持できるよう。 に、保磁力及び重直磁気異方性が大きいことが望まれ

【0028】また、メモリ層13の膜厚は、記録磁区を 安定に保持できるような映厚とすることが望まじく、具" 体的には、60nm~100nm程度が好ましい。 【0029】以上のようなメモリ層13の材料として は、例えば、TbFeCoやTbFeCoCr等が挙げ られる。

:. °/

【0030】つぎに、光磁気記録媒体からDWDD方式 により信号を再生する際の動作について、記録層3を構 成する各級性層11,12,13の磁化の遷移の具体的 な一例を示した図2万至図10を参照して説明する。な ね。ここでは媒体としてディスク状のものを想定し、デ

イスクの回転により、記録再生時に光磁気記録媒体は図 中左方向へ移動するものとする。

【0031】この光磁気記録媒体においては、記録層3 を構成する3層の磁性層(ディスプレイスメント層1 1、スイッチ層12、メモリ層13) はいずれも垂直機 化膜であ り、それらの磁化は、図2に示すように、少な くども常温及び再生時の温度において関面に対して垂直 方向を向く。そして、記録層3を構成する各級性層1 1, 12, 13の層間には交換結合が作用し、そのた め、通常の状態では、図2に示すように、各棋性層1 12, 13のスピンの方向は揃っている。なお、図 2乃至図10において、上下方向を向いた矢印が、各磁 性層のスピンの方向 (例えば透移金属であ るFeあ るい はCo等の磁化方向)を示している。

【0032】この光磁気記録媒体に対する記録には、通 常の光磁気記録に用いられる光変調記録方式又は磁界変 調記録方式が用いられる。そして、この光磁気記録媒体 に対する記録は、主にメモリ暦13に対してなされ、メ モリ暦13のスピンの向きがスイッチ暦12及びディス プレイスメント雇1 1に転写されることによって記録が 完結する。すなわち、例えば図2に示すように、メモリン・シェラハ・カット) **層13に光磁気記録によって記録改区 6.1 (売8.2)。 6 章 (1)、たら頃に 15 に、**た 3、・・・が記録され、それらの記録磁気を主から2、182、 83、・・・がスイッチ層12及びディスプレイスメン 199年間19月間 ト層11に転写され、その結果、スイッチ層12に磁区 199年間(1997年) b1、b2、b3、・・・が形成されるととも標準ディでは発射(第78)年(1997年)

【0033】そして、この光磁気配益媒体から信号を再せてする。 2.65年2年7、生する際は、図3に示すように、ディスプレイスメントによれるインデザンにある11が形成されている側から再生光しを照射する。これでであるのでは、最 の再生光しの照射により、光磁気記録媒体の温度が上昇 する。すなわち、図3に示すように、再生光量を照射変額と得済する特別の ることにより、当該再生光上が照射された部分の媒体の方は、同時にははな 温度が上昇する。ただし、再生時にはディスクが回転® : きばくそ (神経の は一場 動されるので、媒体温度のピーク位置 Pは、適用生光スポリー温度ではしませない ットの中心位置らよりも、当該再生光スポットの走行方言語は個々姿態には持て 向に対して若干後方に位置することとなる。組力多方素造化主集内性が記念してき

シモリ寝ずさたち あん

医魏尔德姆特拉内氏征

スプレイスメント層11に磁区 c 1,5 c 2 遅度3,5 ~ 5. ~

・が形成される。

【0034】ここで、再生光しが照射される記録層3を 構成する3層の磁性層1 1, 12, 1(3のうち) 最も中でも見望するようでは コリー温度 TC2が低く設定されているのは、FC4プラ屋 コロロック 100 では 1.2である。 そして、再生光 Lのパワーは、当該再生光 マルビュー 指導が必要 Lの開射により、スイッチ屋 1.2の温度がキュリー温度 コン・エー 第一日は TC2を超えるように、且つ、ディスプレイスマント層 1 1やメモリ層13の温度がそれらのキュリー温度TC1, TC2を越える部分が生じ、その部分の磁化が消失する。 なお、図3乃至図10では、温度がスイッチ層12のキ

ュリー温度 T はを越え、スイッチ層 12の磁化が消失し た領域(以下、磁化消失領域と称する。)を、斜線を施 して示している.

【0035】そして、スイッチ層12のキュリー温度工 C2以上に温められた領域では、ディスプレイスメント層 11とメモリ層13との間の交換結合が働かなくなる。 ここで、メモリ暦13は、磁気異方性が大きく保護力が 高い磁性材料、例えばTbFeCoやTbFeCoCr 等により構成されるため、他の磁性層との交換結合が消 失しても、記録状態に変化は現れない。一方、ディスプ レイスメント層11は、メモリ層13とは逆に、磁気異 方性及び保礙力が小さく、且つ、記録磁区の周囲に形成 される磁壁が容易に移動し易い材料、例えばGdFeC oやGdFe Co Cr等により構成される。

【0036】そのため、図3に示すように、再生光しの 照射による温度上昇によりスイッチ層 12の磁区 b2, b3の一部の磁化が消失して、当該磁化消失領域の上下 にあ るディスプレイスメント層11とメモリ層13との 間の交換結合が働かなくなると、当該磁化消失領域の上 にあ るディスプレイスメント層1 1 の磁壁 (図3の例で はディスプレイスメント層11の磁区c2と磁区c3と の間の磁壁 σ 1)が、磁気的エネルギーが低くなるよう な方向へ移動する。磁気的エネルギーが低くなるのは、 当該磁壁の 1 が温度の高い位置にあ る状態であ る。した がって、当該磁壁σ1は、図3中の矢印M1に示すよう に、媒体温度のピーク位置Pに向かって移動し、その結 果、図 4に示すような状態となる。

【0037】 ディスプレイスメント層 11において磁盤 σ1が媒体温度のピーク位置Pに向かって移動すること により。図4に示すように、ディスプレイスメント層 1 1の磁区 3が拡大することとなる。すなわち、再生光 スポッドの走行方向前方においてディスプレイスメント。 層 1:1 の磁量 σ 1 がスポット中心方向に移動して、メモ リ暦:1 3の記録磁区 a 3に対応するディスプレイスメン ト層 1:1 の磁区 c 3が拡大する。その結果、メモリ層 1 3の記録磁区 e 3が微小であったとしても、再生に寄与 するディスプレイスメント層11の磁区c3が拡大され ているので、大きな再生信号が得られるようになる。 【0038】その後、ディスクの回転に伴い、図5に示 すように、メモリ層13の記録磁区 a 3とディスプレイ スメント層11の磁区 6 3 との間が全て磁化消失領域に なると、メモリ暦13の記録磁区 a 3 とディスプレイス メント暦11の磁区 a 3 との間の交換結合が切れる。す ると、ディスプレイスメント層11の磁区 c 3と磁区 c 4との間の磁壁σ2が、磁気的エネルギーが低くなるよ うな方向へ移動する。磁気的エネルギーが低くなるの は、当該磁量で2が温度の高い位置にあっる状態である。 したがって、当該磁盤 o 2 は、図5中の矢印M2に示す ように、媒体温度のピーク位置Pに向かって移動し、 そ の結果、図6に示すような状態となる。

【0039】ディスプレイスメント層11において磁型 σ2が媒体温度のピーク位置Pに向かって参勤すること により、図6に示すように、ディスプレイスメント層1 1の磁区 c 4が拡大することとなる。すなわち、再生光 スポットの走行方向前方においてディスプレイスメント 層11の磁壁σ2がスポット中心方向に移動して、メモ り暦 1 3の記録磁区 e 4 に対応するディスプレイスメン ト層11の磁区c4が拡大する。その結果、メモリ層1 3の記録機区84が微小であったとしても、再生に寄与 するディスプレイスメント層11の磁区 c 4が拡大され ているので、大きな再生信号が得られるようになる。 【0040】その後、ディスクの回転に伴い、図7に示 すように、メモリ暦 † 3 の記録磁区 a 4とディスプレイ スメント層11の磁区 c 4 との間が全て磁化消失領域に なると、メモリ暦13の記録磁区84とディスプレイス メント層11の磁区c4との間の交換結合が切れる。す ると、ディスプレイスメント層11の磁区 6.4と磁区 6 5との間の磁筆σ 3 が、磁気的エネルギーが低くなるよ うな方向へ移動する。磁気的エネルギーが低点なるの は、当該磁壁σ3が温度の高い位置にある状態である。 したがって、当該磁壁σ3は、図7中の矢印M3に示す 12 F 25 ように、媒体温度のピーク位置Pに向かって移動し、そ の結果、図7に示すような状態となる。2000年の1997年 2010年1997年 【0041】ディスプレイスメント層:無控おいて磁量・ σ3が媒体温度のビーク位置Pに向かって移動すること により、図フに示すように、ディスプレイスメント層1 2第7 1の磁区。5が拡大することとなる。選す使わち近再生光 2000 スポットの走行方向前方においてディスプレイスメント 3の記録機区 9.5が微小であったとしてもに再生に寄与いたによってあるディスプレイスメント層 1.1の機区 6.5が嫁大され、アー・マー・ マン・コスノレイスメント度11の磁区で5が拡大され、だった。 ているので、大きな再生信号が得られるようになる。 【0.042】以上のように、この光磁気記録媒体では、 映温度がスイッチ度12のキュリー温度下で以上となった。 だ領域でのディスプレイスメント度キャの選集を新に た領域でのディスプレイスメント層 1 1の磁量移動によ り、実効的に記録語区の大きさが拡大し、メモリオ・3 音楽は に形成されている記録的区が強小であったとしても、大 きか重生信号を得ることが可能となっている。すなわべ きな再生信号を得ることが可能となっている。すなわり . ち、図3から図8に示したような一連の磁整線動動作に より、通常の光学系では再生できないような機細な記録 磁区からも、信号を再生することが可能と後っている。 【0043】ところで、その後、更にディスクが回転して、図9に示すように、メモリ暦13の記録破区e3の 左端がスイッチ層 1 2の磁化消失領域の左端位置を通過 4152. すると、温度が低下してスイッチ層12の磁化が回復す る。すると、メモリ層13の記録磁区83と同じ方向の。 スピンがスイッチ層12に生じ、さらに、スペッチ層1

2とディスプレイスメント層11との交換結合により、

11.7

10.00 (1

. A

ディスプレイスメント層11にも同じ方向のスピンが生じる。その結果、メモリ層13の記録磁区 e 3に対応した磁区 c 3がディスプレイスメント層11に再び形成され、ディスプレイスメント層11に新たな磁盤 σ e が生じる。

【〇〇44】すると、ここで生じた磁壁の a も磁気的エネルギーが最小となる位置まで移動する。磁気的エネルギーが低くなるのは、当該磁度の a が温度の高い位置にある状態である。したがって、このときの磁壁の a の移動に、スポット中心方向への移動であり、換言すれば、ディスプレイスメント層 1 1 の磁区 c 3を拡大させる方向への移動である。すなわち、当該磁壁の a は、図9中の矢印M4に示すように、媒体温度のピーク位置 Pに向かって移動し、その結果、図10に示すような状態となる。

. .

4 / 24

٠.

3 ----

【0046】このように、DWDD方式による信号再生時には、記録磁区が再生光スポットを一旦通過した後に、当該記録磁区の拡大動作が再生光スポットの移方領域においても生じるので、再生光スポットの前方領域で既に1度再生した信号が、再び再生されてしまう。ずなわち、DWDD方式では、一つの記録磁区に対して、時間のずれた2つの信号が検出される。このうち、2つ目の信号は、本来は再生されないことが望ましいたの、ゴースト信号と呼ばれる。

【0047】ここで、一つの記録磁区に著目して、当該 記録磁区から得られる信号の時間変化を測定した結果の一切を図11に示す。図11に示すように、DWロケレスで信号を再生したときには、一つの記録磁区に対して、時間のずれた2つの信号を11は、再生光スポット走行方向の前方位置において磁区が拡大したときに得られる信号であり、本来ならば、この信号を1だけを再生することが検出される。この信号を2が検出される。この信号を2次では、再生光スポット走行方向の後方位のによいて磁区が拡大したときにより得ら2が検出される。この信号を2次である。

【0048】以上のように DW D D方式を採用して信号を再生したときに生じるゴースト信号は、再生信号のノイズとなるため、 DW D D方式を採用して高記録 度化を図る上での妨げとなっている。 しかし、ディスプレイスメント 層11において歯患が移動するためには、ディスプレイスメント層11と交換結合している領域が、ある程度の長さ以上でなければならないので、メモリ層13に形成されている記録磁区の周期が十分に短い場合には、ゴースト現象は生じない。このことを図9を参照して説明する。

【0049】図9に示したように、メモリ層13の記録 磁区 a 3の左端がスイッチ層12の磁化消失領域の左端 なるに対応した 磁性 a 3の左端がスイッチ層13の記録磁区 a 3に対応した磁区 c 3がディスプレイスメント層11に形成される。しかし、メモリ層13の記録磁区 a 3の左端がした場区 c 3の形成は、メモリ層13の記録磁区 a 3の左端が磁化消失領域の左端位置を通過したときに直ぐになられるのではない。すなわち、メモリ層13の記録磁区 a 3の左端が磁化消失領域を通ぎて、メモリ層13の記録磁区 a 3 かに大きりはない。スイッチ層12の磁化が回復した領域が十分に大き11に形成され、当該磁区 c 3の磁度 σ a の参動が始まる。

【0050】 このように、再生光スポット走行方向の後方位置における磁壁σοの移動は、メモリ屋1.1の記録 磁区 6 3の左端が磁化消失領域の左端位置を通過してしばらくしてから生じる。したがって、メモリ屋1.3 に形 はされている記録磁区の周期が十分に短い場合(すなわち記録マークが十分に小さい場合)には、既に再生が完了しているメモリ屋13の記録磁区 6 3に対応したディスプレイスメント屋11の磁区 6 3が、再生光スポットの後方位置において、再び再生光スポット内に入ってきてしまうようなことは無くなる。

【0051】以上のように、記録マークを主分に小さくし、記録成区の周期を十分に短くすれば、ゴースト信号が現れなくなるということを検証するために、記録マーク長を0.2~2人を0.2~2人を0.2~2人を0.2~2人を0.2~2人を0.2~2人を0.2~2人を0.2~2人に信号の再生を行った。こそして、ゴースト信号が検出されるか否かを調べたところ、記録マーク長が0.3~2~mや0.1~2小mのときには、ゴースト信号は検出されなかった。このことから、記録マークを十分に小さくし、記録成区の周期を十分に短くすれば、ゴースト信号が現れないようになり、具体的には記録マークを同識できることが分かった。

ースト信号の影響を回避できることが分かった。 【0052】以上のように、メモリ暦13に形成されている記録磁区の周期が十分に短い場合には、ゴースト現象は生じない。そこで、本発明では、光磁気記録媒体に 信号を記録するにあ たって、記録マークの間隔を変調させて信号を記録するマークポジション記録方式により、 デジタル信号を記録するようにする。

【0053】従来、光磁気記録媒体に対して高密度にデジタル信号を記録する際は、記録マーク長を変調して信号を記録するマークエッジ記録方式が採用されていた。マークエッジ記録方式は、比較的に長い記録マークを用いても高密度記録化を進めることができるので、DWD D方式を採用しないような場合には、高記録密度化を図る上で有効であった。

【〇〇54】しかしながら、マークエッジ記録方式では、記録マーク長を変調するので、短い記録マークから長い記録マークまで、長さの異なる複数の記録マークを用いることとなる。そのたの、マークエッジ記録は方式で記録された信号を、DW DD方式で再生しようとすると、長い記録マークのところで、上述したようなゴースト信号が現れやすかった。そのため、マークエッジ記録方式で記録していたのでは、信号の再生にDW DD方式で記録していたのでは、信号の再生にDW DD方式を採用しても、高記録密度化を進めることが難しかった。

【OO55】これに対して、本発明ではマークボジション記録方式を採用している。マークボジション記録方式を採用している。マークボジション記録方では、記録マークと記録マークとの間隔に情報を持たせることとなるので、使用する記録マークは、マニ母マークを変に記録マークで良い。そのに強くしてもいるようにはいる。したがって、DWDD方式において、マークになる。したがって、DWDD方式において、マークボジション記録方式を採用することにより、コースト信号の影響を回避して、高記録密度化を進めることが可能となる。

【0056】なお、上述した実験の結果からも分かるように、記録マーク長がの、2pm以下であれば、ゴースト信号が現れないようになる。したがって、マークボジション記録方式を採用するにあたっては、その記録マーク長を0、2pm以下とすることが好ましい。
【0057】ところで、マークボジション記録方式にお

【0057】ところで、マークポジション記録方式において、更なる高記録密度化を図るには、記録マーク長をより短くすることが望まれる。そして、記録マーク長を短くするということは、ゴースト信号が現れなくなる方向への変更である。したがって、この点からも、DWDD方式において、マークポジション記録方式を採用するということは、更なる高記録密度化を進める上で非常に有効である。

:. ·

【0058】 つぎに、マークボジション記録方式による記録再生について、具体的な一例を挙げて説明する。なな、ここでは、(1,7)RLL変調方式を用いた例を挙げるが、本発明においてデジタル信号の変調方式は特に限定されるものではなく、任意の変調方式が採用可能

である。

100

【0059】まず、記録過程について、図12及び図13を参照しながら説明する。なお、記録過程における信号処理方法は、マークポジション記録を行うものであれば、どのような方法でも良く、以下に説明するような方法に限定されるものではない。

【0060】記録時には、先ず、「0」「1」からなる入力データピット列を、符号器21によって、図12(a)に示すように、NRZ(Mon Return to Zero)の(1,7)変調データA1に変調する。次に、当該変調データA1を、記録用増幅器22によって、図12(b)に示すように、方形波状の記録電流A2に変換し、当該記録電流A2を光ピックアップ23に供給する。そして、光ピックアップ23に供給する。そして、光ピックアッド120によりままませた。

る。そして、光ピックアップ23は、記録電流A2に基 ついて、レーザダイオードLDからレーザ光を出射し当 該レーザ光を光磁気記録媒体に照射するとともに光磁気 記録媒体に磁界を印加して、図12(c)に示すよう に、光磁気記録媒体に対して光磁気記録により記録マー クを記録する。

【0061】このとき、光磁気記録媒体には、各記録マークが変調データの「1」にそれぞれ対応するように記録する。これにより、光磁気記録媒体には、短い一定のマーク長の記録マークが多数記録され、貼り合う記録マークの間隔が情報を示すこととなる。なお、このようにマークボジション記録方式によって光磁気記録媒体に記録マークを記録するにあたって、それらの記録マークのマーク長は、上述したように、0、2μm以下とすることが好ましい。なお、このときの記録方式は、記録電流A2を磁気ヘッドに送って記録する磁界変調方式でも良い。

【0062】つぎに、再生過程について、図12及び図14を参照しながら説明する。なお、再生過程における信号処理方法は、マークボジション記録方式によって記録された記録マークの中心位置を挟出するようなものであれば、どのような方法でも良く、以下に説明するような方法で限定されるものではない。

【0053】再生時には、先ず、図12(c)に示すように光磁気記録媒体に記録されている記録マークを、光ピックアップ23により、上述したようなDWDD方式により検出する。このとき、光ピックアップ23は、光磁気記録媒体からの反射光をフォトダイオードPDからの出いて検出する。そして、フォトダイオードPDからの出力は、再生用増幅器24によって増幅されるとともに電圧信号に変換されて、図12(d)に示すような波形の再生信号B1として出力される。ここで、光磁気記録媒体に記録されている記録マークは、短く且つ一定のマーク長の記録マークであるので、DWDD方式を採用して再生しても、ゴーストの影響を受けることなく、良好な再生信号B1が得られる。

: :: : :

7;

【0064】そして、再生用増幅器24から出力された

再生信号B1は、低域通過フィルタ25によって高周波成分が減衰されて、図12(e)に示すような波形の信号B2とされた上で、微分器26と第1の弁別器27とにそれぞれ供給される。ここで、微分器26は、低域通過フィルタ25を通過してきた信号B2の微分成分を求めて、図12(f)に示すような微分信号B3を生成し、当該微分信号B3を第2の弁別器28に供給する。

【0065】そして、第1の弁別器27は、低域通過フィルタ25を通過してきた信号B2から、図12(g)に示すような2値化信号B4を生成し、また、第2の弁別器28は、微分器26から供給された微分信号B3から、図12(h)に示すような2値化信号B5を生成する。なお、このときの弁別器27,28の弁別レベルは、ほぼ短幅中心としておく。

【0066】次に、比較器29により、第1の弁別器27により生成された2値化信号84と、第2の弁別器28により生成された2値化信号85とを比較し、それらの更独信号成分を取り出し、図12(i)に示すような再生信号パルス86を生成する。

【〇〇67】以上のようにして、記録されたデータに対応した再生信号パルスB6が得られる。ただし、この再生信号パルスB6を用いて、位相なく、更に、この再生信号パルスB6を用いて、位相は30、低域通辺フィルタ31及び竜圧射御充振器32からなるPLL(Phase Locked Loop)33により、国生クロックを抽出し、当該再生クロックで同期をとって、同期処理回路34により、図12(j)に示すような月期の一タB7を生成する。そして、この再生データB7を、復号器35によって復号することにより、もとのデータピット列が再生される。

【0068】以上のように、マークエッジ記録方式によって記録再生を行った場合には、光磁気記録媒体に記録される記録マークが、短く且つ一定のマーク長の記録マークだけとなるので、DWDD方式で信号を再生しても、ゴーストの影響を受けることなく、良好な再生信号が得られる。したがって、マークエッジ記録方式によって記録再生を行うようにすることで、ゴースト信号の影響を回避して、更なる高記録密度化を図ることが可能となる。

[0069]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によれば、DWDD方式におけるゴースト現象を解消することができ、光磁気記録媒体の更なる高記録密度化を図ることが可能となる。

を行っていないときの記録層の俄区状態を示す模式図で あ る。

・ [図3] 3 屋構造の記録層を有する光磁気ディスクにおける機型移動動作を説明するための図であり、再生光しを照射したときの機区の状態及び媒体の温度プロファイルを示す模式図である。

【図4】3層構造の記録層を有する光磁気ディスクにおける磁盤移動動作を説明するための図であり、ディスプレイスメント層の磁区 c 3の磁盤が移動した状態を示す模式図である。

【図5】3層構造の記録層を有する光磁気ディスクにおける磁壁移動動作を説明するための図であり、メモリ層の磁区 63とディスプレイスメント層の磁区 c3との交換結合が切れた状態を示す模式図である。

【図5】3層構造の記録層を有する光磁気ディスクにおける磁壁移動動作を説明するための図であり、ディスプレイスメント層の磁区 c 4 の磁壁が移動した状態を示す模式図である。

【図7】3層構造の記録層を有する光磁気ディスクにおける概量移動動作を説明するための図であり、メモリ層の磁区 9.4 とディスプレイスメント層の磁区 6.4 との交換結合が切れた状態を示す模式図である。

【図8】3層構造の記録層を有する光磁気ディスクにおける機壁移動動作を説明するための図であり、ディスプレイスメント層の機区 o 5の機壁が移動した状態を示す模式図である。

【図9】3層構造の記録層を有する光磁気ディスクにおける磁盤移動動作を説明するための図であり、メモリ層の磁区3の左端が磁化消失領域の左端位置を通過した状態を示す模式図である。

【図10】3層構造の記録層を有する光磁気ディスクに おける磁量移動動作を説明するための図であ、り、ディス プレイスメント層の磁区 ○3の磁量が移動した状態を示 す模式図である。

【図11】 - つの記録機区に着目して、当該記録機区から得られる信号の時間変化を測定した結果を示す図である。

【図12】マークボジション記録方式の記録再生過程に おける信号の流れを示す図である。

【図 1.3】光磁気記録再生装置の記録処理系の一構成例を示すブロック線図である。

【図14】光磁気記録再生装置の再生処理系の一構成例を示すプロック線図である。

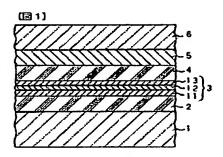
【符号の説明】

1 遠明基板、 2 誘電体膜、 3 記録層、 4 誘電体膜、 5 反射膜、 5 保護膜、 11 ディ スプレイスメント層、 12 スイッチ層、13 メモ リ層

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用した光磁気記録媒体の一構成例を示す要部版時断面図である。

[図2] 3 層構造の記録層を有する光磁気ディスクにおける磁量移動動作を説明するための図であり、記録再生

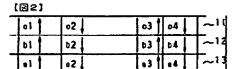


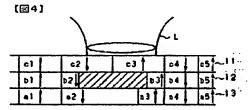


1: 西門 2: 別版集集 3: 配場着 4: 西東海 5: 岳田田

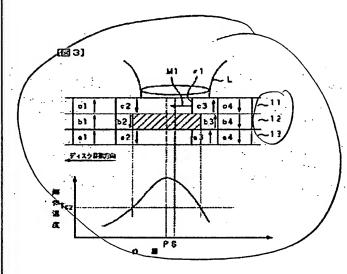
6:保証券 11:ディスプレイスメント層 12:スイッフ度 13:メモリ港

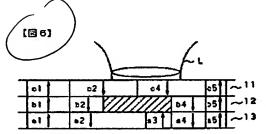
RESTRUCTED BY





サイスクロン方向



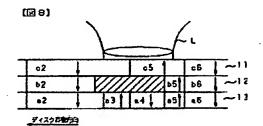


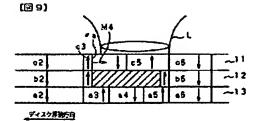
ディスクを制力

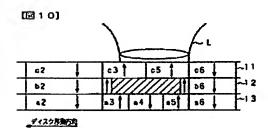
[図5]	1		,	
	. }	M5 .5	fi	
cl	c2	031-4	04 o!	-11
61	52		D4 D5	~12
41	a2	a3 †	04 0	-13
713	98 16 578			

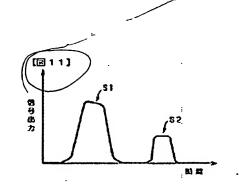
[27] c2 , **b2** ь6 •2

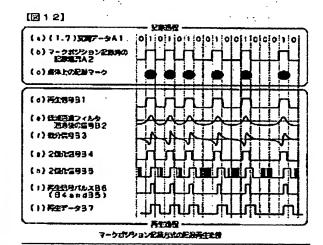
ディスク中華大河

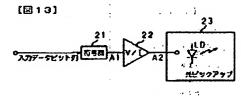




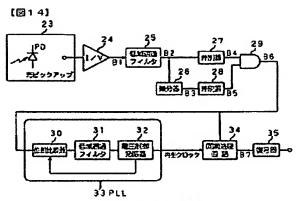








产品的工具等企业整心是对无效系的概点



大田本PSF江江南の東王江東名の4.1

「翻訳文」

発送日付: 2003.11.26. 提出期日: 2004.01.26.

特 許 庁 意見提出通知書

出 願 人 キヤノン株式会社

代理人 慎重勛 外1名

大韓民国 SEOUL特別市 瑞草区 瑞草 4 洞 1678-2 東亞Villart 2 Town 302号

出願番号 10-2002-0001144

発明の名称 DOMAIN WALL-DISPLACEMENT TYPE MAGNETO-OPTICAL MEDIUM AND

REPRODUCING METHOD FOR THE SAME

この出願に対する審査の結果、下記のような拒絶理由があるので、特許法第63条の規定によりこれを通知しますから、意見があるとか補正を要する場合には、上記提出期日までに意見書[特許法施行規則別紙第25号の2書式]又は/及び補正書[特許法施行規則別紙第5号書式]を提出されたい(上記提出期日に対して、毎回1月単位で延長を申請することができ、この申請に対し別途の期間延長承認の通知は行いません)。

【理由】

この出願の特許請求の範囲の請求項1乃至5に記載された発明は、その出願前にこの 発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が下記に指摘したものに基づいて 容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により 特許を受けることができない。

【記】

本願の請求項1乃至5は、磁壁移動型光磁気記録媒体及びその再生方法に関するもので、これは、日本公開特許公報11-339340号(1999.12.10.公開)に記録装置、記録方法及び光磁気記録媒体に関する技術が記載されているところ、本願の磁壁移動層、記録層、磁壁移動層と記録層間に設けられるスイッチング層の構成を特徴とする光磁気記録媒体は、引用発明のディスプレイスメント層11、メモリ層13、ディスプレイスメントとメモリ層との間に形成されるスイッチング層12の構成を特徴とする光磁気記録媒体と対応し、本願の記録媒体にスイッチング層のキュリー温度を超えるようにレーザー光により形成するステップ、スイッチング層のキュリー温度を超える温度域の領域において磁壁移動層と記録層間の間の交換結合を切断するとともに、磁壁移動層に形成された磁壁を前記温度分布の温度勾配に基づき高温側に移動させるステップ、記録層に

<u>ا</u> ۔

蓄積された情報を検出するステップとを含む再生方法は、引用発明の再生光の照射による温度上昇によってディスプレイスメント層とメモリ層との間の交換結合が切れ、ディスプレイスメント層の磁壁が温度のピーク位置Pに移動し、再生信号が得られることを特徴とする再生方法に対応するもので、本願は引用発明の構成と類似し、効果においても著しい差異を発見することができない。よって、本願は、上記引用発明などの構成に基づいて、当業者水準で容易に発明をすることができたものである。

[添付]

添付1 日本公開特許公報11-339340号(1999. 12. 10.) 1部 2003.11.26.

特許庁

- ichot

출력 일자: 2003/11/27

발송번호 : 9-5-2003-046619713

수신 : 서울 서초구 서초4동 1678-2 동아빌라트2

발송일자 : 2003.11.26

타운 302호

제출기일 : 2004.01.26

신중훈 귀하

137-882

특허청 의견제출통지서

출원인

명칭 캐논 가부시끼가이사 (출원인코드: 519980959073)

주소 일본 도꾜도 오오따꾸 시모마른꼬 3쪼메 30방 2고

대리인

성명 신중훈 외 1명

주소 서울 서초구 서초4동 1678-2 동아빌라트2타운 302호

출원번호

10-2002-0001144

발명의 명칭

자벽이동형 광자기기록애체 및 그 재생방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장 승인통지는 하지 않습니다.)

[이 유]

이 출원의 특허청구범위 제1항 내지 제5항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분 야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특 허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다. [아래]

본원의 청구항 제1항 내지 제5항은 자벽이동형 광자기기록매체 및 그 재생방법에 관한 것으로, 이는 일본공개특허공보 11-339340호(1999.12.10 공개)에 기록장치, 기록방법 및 광자기 기록매체에 관한 기술이 기재되어 있는바, 본원의 자벽이동층, 기록층, 자벽이동층과 기록층 사이에 형성되는 스위칭층의 구성을 특징으로 하는 광자기기록매체는 인용발명의 이동층(11), 메모리층(13), 이동층과 메모리층 사이에 형성되는 스위치층(12)의 구성을 특징으로 하는 광자기기록매체와 대응되고, 본원의 기록매체에 스위칭층의 큐리온도를 초과하도록 레이저광에 의해 형성하는 단계, 스위칭층의 큐리온도를 초과하는 온도역의 영역에서 자벽이동층과 기록층 사이의 교환결합을 절단하는 동시에, 자벽이동층에 형성된 자벽을 상기 온도분포의 온도기울기에 따라 고온쪽으로 이동시키는 스텝, 기록층에 축적된 정보를 검출하는 단계를 포함하는 재생방법은 인용발명의 재생광의 조사에 의한 온도상승으로 이동층과 메모리층 사이의 교환결합이 차단되고, 이동층의 자벽이 온도가 높게 되는 위치(P)로 이동하고, 재생신호를 얻는 것을 특징으로 하는 재생방법에 대응되는 것으로, 본원은 인용발명의 구성과 유사하고 효과에 있어서도 현저한 차이를 발견할 수 없습니다. 따라서 본원은 상기 인용발명들의 구성으로부터 당업자수준에서 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

[청 부]

청부1 일본공개특허공보 평11-339340호(1999.12.10) 1부 끝.

2003.11.26

특허청

심사4국

정보심사담당관실

심사관 유주호

2003 11

慎重助特許

출력 일자: 2003/11/27

<<안내>>

문의사항이 있으시면 🗗 042-481-5690 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행 위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다. ▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터